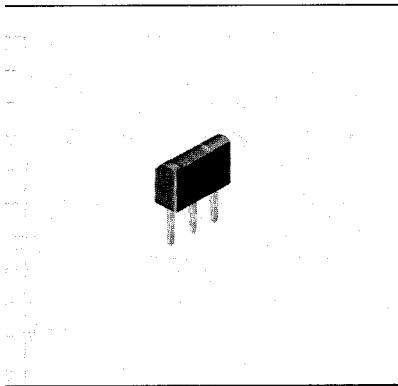


2SD1226M



●外形寸法図

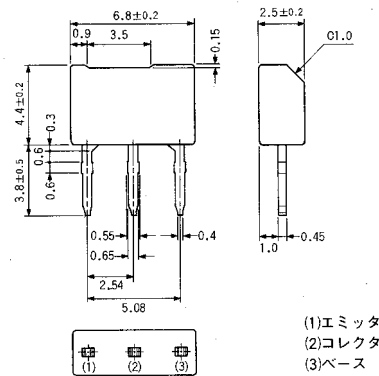


図1 ATR

●特長

- 1) 小型のATRパッケージにて $P_c=1W$ である。
- 2) 高耐圧、大電流である。
 $V_{CE0}=80V$ 、 $I_C \text{ MAX}=700mA$
- 3) 2SB910Mとコンプリである。

●用途

$P_c=60W$ クラスまでのドライバー

●絶対最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

項 目	記 号	最大定格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ電流	I_C	700	mA dc.
		1	A (Pulse)*
コレクタ損失	P_c	1	W
接合部温度	T_j	135	$^\circ C$
保存温度	T_{stg}	-55~135	$^\circ C$

* $P_w=20ms$, duty=1/2

●電氣的特性 ($T_a=25^\circ C$)

項 目	記 号	Min.	Typ.	Max.	単位	条 件
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CE0}	80	—	—	V	$I_C=2mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CB0}	80	—	—	V	$I_C=50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EB0}	5	—	—	V	$I_E=50\mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	—	—	0.5	μA	$V_{CB}=50V$
エミッタシャ断電流	I_{EB0}	—	—	0.5	μA	$V_{EB}=4V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	0.2	0.4	V	$I_C/I_B=500mA/50mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	82	—	390	—	$V_{CE}/I_C=3V/100mA$
利得帯域幅積(トランジション周波数)	f_T	—	120	—	MHz	$V_{CE}=10V$, $I_C=50mA$
出力容量	C_{ob}	—	10	—	pF	$V_{CB}=10V$, $I_E=0$, $f=1MHz$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

アイテム	P	Q	R
h_{FE}	82~180	120~270	180~390